

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»
Институт электронных и информационных систем

Кафедра физики твердого тела и микроэлектроники

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Учебный модуль по направлению подготовки
11.03.04 Электроника и микроэлектроника

Фонд оценочных средств

СОГЛАСОВАНО

Принято на заседании Ученого совета ИЭИС

Протокол № 41 от 25.05 2017 г.

Директор ИЭИС

С.И.Эминов С.И.Эминов

Разработал

Проф. кафедры ФТТМ

М.Н.Петров

« 18 » 05 2017 г.

Принято на заседании кафедры ФТТМ

Протокол № 10 от 22.05 2017 г.

Заведующий кафедрой ФТТМ

Б.И. Селезнев Б.И. Селезнев

Паспорт фонда оценочных средств
по модулю «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации»
для направления подготовки 11.03.04 Электроника и нанoeлектроника

Таблица 1

Модуль, раздел (в соответствии с РП)	ФОС		Контролируемые компетенции (или их части)
	Вид оценочного средства	Количество вариантов заданий	
УЭМ1 Общие вопросы технического перевода			
Тема1. Введение			ОК-5
Тема 2. Лексические вопросы перевода технической литературы	отчет по СР	1	
Тема 3. Грамматические вопросы перевода	отчет по СР	1	
Тема 4. Особенности перевода научно-технической литературы	отчет по СР	1	
Тема 5. Перевод аббревиатур, рекламы и патентов	отчет по СР	1	
УЭМ2 Технические средства			
Тема 6. Электронные словари	отчет по СР	1	ОК-5
Тема 7. Системы машинного перевода	отчет по СР	1	
Тема 8. Онлайн-овые средства переводчика	отчет по СР	1	
Рубежная аттестация	тестирование	1	
Тема 9. Основная терминология по операционной системе Windows	отчет по СР	1	
УЭМ3 Термины, жаргон и аббревиатура дисциплин профессионального цикла			
Тема 10. Основные понятия и термины физики полупроводников	отчет по СР	1	ОК-5
Тема 15. Физика полупроводниковых и микроэлектронных приборов	отчет по СР	1	
Тема 16. Технология интегральной схемы	отчет по СР	1	
Тема 17. Элементная база СБИС	отчет по СР	1	
Тема 18. Системы автоматизированного проектирования ИС	отчет по СР	1	
Аттестация	зачет	21 вопрос	

Характеристики оценочных средств

1 Отчет по самостоятельной работе

По результатам самостоятельной работы по темам студенты оформляют отчеты. Отчет должен содержать: оригинальный текст, перевод, словарь неизвестных технических слов. Для самостоятельной работы студенты могут также использовать источники, представленные в таблице 2 ФОС.

Таблица 2 – Параметры оценочного средства (отчет)

Источники	1. S . M. Sze and Kwok K. Ng Physics of Semiconductor Devices, 3rd Edition , 2007: John Wiley & Sons.- 815 p. 2. Electronic Device Architectures Nano-CMOS Era. From Ultimate CMOS Scaling to Beyond CMOS Devices. Ed. Simon Deleonibus.- 2009: Pan Stanford Publishing.- 425 p. -Verlag Berlin Heidelberg 3. Chips 2020. A Guide to the Future of Nanoelectronics. Ed. Bernd Hoefflinger.- 2012: Springer.- 477 p. 4. Gordon McComb, Earl Boysen Electronics For Dummies. 2005: Wiley.- 416 p. 5. Bhattacharyya A.B. COMPACT MOSFET MODELS FOR VLSI DESIGN.- 2009: Wiley.- 432 p. 6. Armstrong G.A., Maiti C.K. TCAD for Si, SiGe and GaAs Integrated Circuits. - 2007, London: The Institution of Engineering and Technology.- 443 p. 7. Norman J. Medoff, Barbara K. Kaye. Electronic Media. Then, Now, and Later. Second Edition.- 2011: Elsevier.- 306 p. 8. Simon Li, Yue Fu 3D TCAD Simulation for Semiconductor Processes, Devices and Optoelectronics.- 292 p. 9. Dragica Vasileska, Stephen M. Goodnick Computational Electronics.- 2006: Morgan & Claypool.- 208 p. 10. KEVIN F. BRENNAN, APRIL S. BROWN THEORY OF MODERN ELECTRONIC SEMICONDUCTOR DEVICES. -2002: JOHN WILEY & SONS.- 448 p. 11. Marian Adamski, Alexander Barkalov Design of Digital Systems and Devices.- 2011: Springer.- 365 p. 12. PAUL R. GRAY, STEPHEN H. LEWIS, ROBERT G. MEYER ANALYSIS AND DESIGN OF ANALOG INTEGRATED CIRCUITS. Fifth Edition.- 2009: JohnWiley & Sons.- 881 p. 13. Attia O. John. Pspice and Matlab for Electronics: an integrated approach/ 2- nd ed. - 2010: CRC.- 355 p. 14. David L. Pulfrey Understanding Modern Transistors and Diodes.- 2010: Cambridge University Press.- 335 p.
Критерии оценки:	
9-10 баллов	в отчете минимальное количество стилистических и грамматических ошибок
7-8 баллов	допускаются стилистические и грамматические ошибки, но негрубые
5-6 баллов	отчет представлен с ошибками, грубо искажающими содержание оригинала

2 Тестирование

Тест контроля знаний терминологии приведен в приложении А к ФОС, находится в закрытом для студентов доступе, хранится на кафедре.

Таблица 3 – Параметры оценочного средства (тест)

Предел длительности контроля	15-20 мин
Предлагаемое количество заданий	1 тест
Критерии оценки:	
5 баллов	более 90% правильной интерпретации представленных терминов
4 балла	интерпретация представленных терминов правильна на 70-89%
3 балла	интерпретация представленных терминов правильна на 50-69%

3 Зачет

Таблица 4 – Параметры оценочного средства (зачет)

Предел длительности контроля	15-20 мин на подготовку
Предлагаемое количество вопросов	2
Критерии оценки:	
14-15 баллов	даны полные и аргументированные ответы на все вопросы
11-13 баллов	ответы достаточные, но были допущены неточности
8-10 баллов	при ответе допущены существенные ошибки или дан ответ только на один вопрос